



深圳市富满电子集团股份有限公司

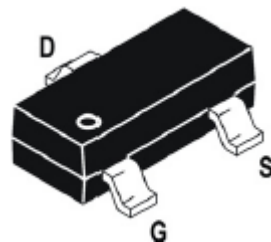
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

3415 (文件编号: S&CIC0937)

12V P 沟道 MOS 场效应管

特点

- 超低电阻
- $R_{DS(ON)} < 55m\Omega @ V_{GS} = -4.5V$
- $R_{DS(ON)} < 75m\Omega @ V_{GS} = -2.5V$
- 可靠耐用



产品应用

- 笔记本电脑的电源管理, 便携式设备和电池供电的系统。

绝对最大额定值 ($T_A = 25^\circ C$, 除非另有说明)

符号	参数	值	单位
V_{DSS}	漏源电压	-12	V
V_{GSS}	栅源电压	± 8	
I_D	漏极电流	-4	A
I_{DM}	漏极脉冲电流	-10	
T_J	最大结温	150	$^\circ C$
T_{STG}	储存温度	-55 to 150	
$R_{\theta JA}^b$	结环热阻	150	$^\circ C/W$

静态电特性 ($T_A = 25^\circ C$, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
静态特性						
BV_{DSS}	漏源击穿电压	$V_{GS} = 0V, I_{DS} = 250\mu A$	-12			V
I_{DSS}	栅源短路时, 漏极电流	$V_{DS} = -12V, V_{GS} = 0V,$			-1	μA
		$T_A = 85^\circ C$			-10	
$V_{GS(th)}$	栅极阈值电压	$V_{DS} = V_{GS}, I_{DS} = 250\mu A$	-0.5	-0.7	-1.4	V
I_{GSS}	栅漏电流	$V_{DS} = \pm 8V, V_{GS} = 0V$			± 100	nA
$R_{DS(ON)}$	内阻	$V_{GS} = -4.5V, I_{DS} = -3.0A$		50	55	m Ω
		$V_{GS} = -2.5V, I_{DS} = -2.0A$		68	75	
		$V_{GS} = -1.8V, I_{DS} = -1.0A$		110	120	
V_{SD}	二极管正向电压	$I_{SD} = -3.5A, V_{GS} = 0V$			-1.3	V
R_G	栅极输入电阻	$V_{GS} = 0, V_{DS} = 0, V$ Frequency = 1MHz	--	6	--	Ω